

60Vシリーズ パワー-MOSFET

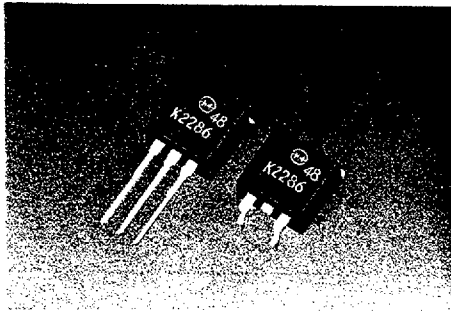
60V SERIES POWER MOSFET

高速スイッチング
N-チャネル、エンハンスメント型

2SK2286

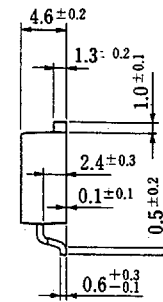
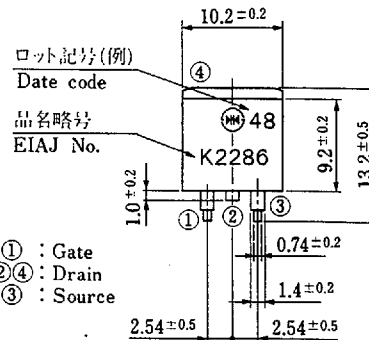
(F20S6N)

60V 20A



外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Case : ST0-220



[Unit : mm]

定格表 RATINGS

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項 目 Item		記 号 Symbol	条 件 Conditions	規 格 値 Ratings	単 位 Unit
保存温度 Storage Temperature		Tstg		−55~150	℃
チャネル温度 Channel Temperature		Tch		150	℃
ドレイン・ソース電圧 Drain・Source Voltage		V _{DSS}		60	V
ゲート・ソース電圧 Gate・Source Voltage		V _{GSS}		±20	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	DC	I _D		20	A
	Peak	I _{DP}	パルス幅≤10μs, duty≤1/100 Pulse width≤10μs, Duty cycle≤1/100	80	A
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)		I _S		20	A
全損失 Total Power Dissipation		Pr	T _C =25℃	60	W
アバランシェ電流 Avalanche Current		I _{DA}	T _C =25℃	20	A

電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_C=25°C)

項 目 Item	記 号 Symbol	条 件 Conditions	規 格 値 Ratings			単 位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DS}	I _D =1mA, V _{GS} =0V	60			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{DS} =60V, V _{GS} =0V			100	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} =±20V, V _{DS} =0V			±10	μA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	I _D =10A, V _{DS} =10V	10	15		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{DS(ON)}	I _D =10A, V _{GS} =10V		0.035	0.045	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	I _D =1mA, V _{DS} =10V	1.0	1.5	2.0	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	I _S =10A, V _{GS} =0V			1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case			2.08	°C/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q _g	V _{GS} =10V, I _D =20A, V _{DD} =48V		56		nC
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}	V _{DS} =10V, V _{GS} =0V, f=1MHz		1500		pF
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}			280		
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}			670		
ターンオン時間 Turn-on Time	t _{on}	I _D =10A, V _{GS} =10V, R _L =3Ω		110	230	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t _{off}			430	900	

8219387 0002201 1T6

Shindengen TOKYO, JAPAN

■ 特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

